

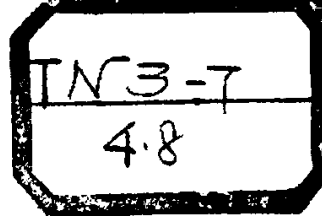
半导体文摘

1983年度主题索引

BANDAOTI

WENZHA

科学技术文献出版社重庆分社



半 导 体 文 摘

一九八三年度主题索引

中国科学技术情报研究所重庆分所 编 辑
科 学 技 术 文 献 出 版 社 重 庆 分 社 出 版
重庆市市中区胜利路91号

新 华 书 店 重 庆 发 行 所 发 行
重 庆 新 华 印 刷 厂 印 刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 29.375 字数: 93万
1985年3月第一版 1985年3月第一次印刷
科技新书目: 81—233 印数: 1800

书号: 17176·389

定价: 9.50元

使用 说明

1. 本索引包含材料主题索引(简称材料索引)和一般主题索引(简称主题索引)两种。所采用的主题词是根据半导体学科的需要并参考“汉语主题词表”拟定的。
2. 本索引原则上采用一级主题词。为了便于查找类似的主题,在部分一级主题词下设立二级主题词。
3. 本索引中所采用的几个简略词的意义:
 - 1) “用”表示采用另一个相当或相近的词作主题词,例如:光伏电池(用:太阳电池)
 - 2) “含”表示该主题词包含另一个相当或相近的主题词,例如:电子显微镜(含:电子显微术)。
 - 3) “参”表示参与该主题词相关的其他主题词。例如:MOS结构(参:MOS晶体管,MOS二极管)。
4. 本索引由主题词和说明语两部分组成。主题词按汉语拼音字母音序排列。主题词不论一级还是二级的均用黑体字排印。
5. 材料索引的主题词属元素符号和分子式者按英文字母次序排列,属汉字表示的材料名词者按汉语拼音字母音序排列。
6. 为了使读者了解本索引的主题词,特将材料主题词和一般主题词分别编成一览表单独列出。
7. 主题索引的著录格式举例如下:

飞点扫描器①

利用斩调光束在飞点扫描器上观察p-n结② 832826③

其中:①主题词,以黑体字排印。

②说明语。

③文摘号,其中前两位数字代表年份,后四位数字为该年度的流水号。

8. 通过索引查到文摘号后,即可根据文摘号从本年度各期文摘中查到所需的文献线索。
9. 为了便于读者判断期次,现将1983年各期的起迄文摘号列出如下:
 - 第1期: 830001至830538
 - 第2期: 830539至831294
 - 第3期: 831295至831923
 - 第4期: 831924至832621
 - 第5期: 832622至833224
 - 第6期: 833225至833873
 - 第7期: 833874至834488
 - 第8、9期: 刊登1982年主题索引
 - 第10期: 834489至835108
 - 第11期: 835109至835816
 - 第12期: 835817至836454
10. 本年度索引由钱坝伯、何朝荣编制。由于缺乏经验,而且时间仓促,难免存在各种缺点错误,敬希读者批评指正。

一九八三年度半导体文摘主题索引

目 录

使用说明

材料词一览表(1)

主题词一览表(9)

材料索引(38)

主题索引(152)

材料词一览表

A

Ag
Ag-GaAs
Ag/Pd
Ag-Si
Ag-Te
AgAsS₂
Ag₃AsS₄
AgBr
AgGaS₂
AgGaSe₂
AgGaTe₂
AgIn₅S₈
Ag₂O
Ag₂S
Ag₃SbS₃
Al
Al/Al-O
Al-Al₂Cu
Al-Al₂O₃
Al-Al₂O₃-GaAs
Al/Al₂O₃/Pb
Al-Au
Al-(CH)_x
Al-Cu
Al-Cu-Si
Al-Ga
Al-GaAs
Al-Ge
Al-InP
Al-O
Al/S|A|Pc/Ag
Al-Sb
Al-Si
Al-多晶硅
Al-SiO₂
Al-SiO₂-nGaAs-n⁺GaAsP-n⁺GaP
Al-SiO₂-Si
Al-SiO₂-SiC

Al-氮化物
AlAs
AlAs-AlGaAs-GaAs
AlAs-GaAs
AlGaAs
AlGaAs-GaAs(用: GaAs-GaAl-As)
AlGaAsSb
AlGaAsSb/GaAs
AlGaAsSb/GaSb
AlGaAsSb/InP
AlGaInAs
AlGaInSb
AlGaP
AlGaSb
AlInAs
AlInAsSb
AlInAs/GaInAs/AlInAs
AlInN
AlN
Al₂O₃
a-Al₂O₃
Al₂O₃-CdSe
Al₂O₃/InP
AlSb
Ar
As
a-As
As/Ga
As-Ge-Se
As-Ge-Te
As-S
As-Se
As-Se-Ag
As-Te
AsCl₃-Ga-H₂
AsCl₃/GaAs-Ga/H₂
AsF₅
AsH₃
As₂S₃

a-As₂S₃
As₂S₃-Ag
As₂S₃-Sb₂S₃
AsSe₃
As₂Se₂
As₂Se₃
a-As₂Se₃
a-As₂S₃-xSe_x
a-AsTe
a-AsTeGeSi
Au
Au/Be
Au-Cd
Au-CdTe
Au-GaAs
Au-GaP
Au-Ge
Au-InGaAsP
Au/InP
Au-Sb
Au-Si
Au-Sn
Au-Zn₃P₂
Au/ZnSe:Mn/Ge
Au₂Al
AuGe
AuGe/GaAs
AuGe-Ni
AuGe/Pt
AuGe/Pt/Au
AuGeNi
AuZn

B

B
B-Ni-Pt
BAs
B₄As
BCl₃
BF₂

B₂H₆
BN
B₂O₃
BP
BaF₂
BaTiO₃
Be
Bi
Bi-Sb
Bi₂O₃
BiSb
Bi₂S₃
BiTe
Bi₂Te₃
Bi₂Te₃-Bi₂Se₃
Bi₂Te₃-Sb₂Te₃
BiTeI
BiTeSe
Br

C

C
C-F
CCl₄
C-O
CF₄
CF₄/O₂
(CH)_x
(CH)_x-Al
(CH₃)₂Te(二甲碲)
CO
CO₂
CaF₂
CaO
CaS
CaSe
Cd
Cd-Pb
a-Cd-Sb
Cd-Sb-Ge
Cd-Te
Cd-Te-N-H-Br
Cd-Tl-Se
Cd-Tl-Te
Cd₃As₂

a-Cd₃As₂
Cd(CH₃)₂-(CH₃)₂S-H₂
CdCl₂
CdCr₂Se₄
多晶CdCr₂Se₄
CdF₂·Ho³⁺
CdGa₂S₄
CdHgTe(用: HgCdTe)
CdI₂
(CdIn₂S₄)_{1-x}-(In₂S₃)_x
CdIn₂Se₄
CdMnSe
CdMnTe
CdO
CdO-SnO₂
CdO-Zn₃P₂
CdP₂
CdPbS
CdS
CdS/CdTe
CdS/Cu
CdS:CuInSe₂
CdS/Cu₂S
CdS-Cu_xS
CdS/InP
CdS/Si
CdS-SiO₂-Si
CdSGeP
CdSSe
CdSTe
(CdS)(ZnS):Cu:Cl
CdSb
CdSe
多晶CdSe
CdSe-Al₂O₃
CdSe-CdS
CdSe-SiO₂
CdSiAs₂
CdSnAs₂
CdSnAs₂-GaSb
CdSnP₂
CdSnP₄
CdTe
多晶CdTe
CdTe-CdS

CdTe-CdHgTe
CdTe-H₂
CdTe-HgTe-Te
CdTl₂Se₄
CdTl₂Se₄-CdTl₂Te₄
CdZnS/Cu₂S
Cl
Cl₂/Ar
Co
CoCuCr₂S₄
CoCuCr₂SSe
Co₂O₃
CoSi₂/Si
Cr
Cr/Au
Cr/Cu
Cr-Ni-Au
Cr//H-Pc//Cr
CrAl₂S₄
CrAsSb
Cr₂O₃
CrSi₂
Cs-Si
Cu
Cu/Cr-Si
Cu-Ge
Cu/Ni-Cr
Cu-酞花青
CuCl₂
CuCr₂Se₄-CuInSe₂
CuCr₂Se₄-InSe
CuCr₂Se₄-In₂Se₃
CuGa₂In_{1-x}S₂
CuGaS₂
CuGaSe₂
CuInCrSe
CuInGaSeTe
CuInS₂
CuIn₂S₈
CuInSe₂
CuInSe₂/Au
CuInSe₂/CdS
CuInSe₂-多硫化物
CuInTe₂
CuO

Cu_2O
 CuS
 Cu_7S
 Cu_{2-x}S
 $\text{Cu}_2\text{S}/\text{CdS}$
 $\text{Cu}_x\text{S}/\text{CdS}$
 $\text{Cu}_2\text{S}/\text{ZnCdS}$
 $\text{Cu}_x\text{S}-\text{ZnS}$
 Cu_2Se
 Cu_2Se_3
 CuTiSe_2
 Cu_2Te
 多晶 Cu_2Te

E

$\text{Eu}_3\text{Sb}_4\text{S}_6$
 $\text{Eu}_3\text{Sb}_4\text{Se}_6$

F

F
 Fe
 FeCrInS
 Fe_2O_3

G

Ga
 $\text{Ga}/\text{AsCl}_3/\text{H}_2/\text{IG}$ (惰性气体)
 Ga/GaAs
 $\text{Ga}-\text{HCl}-\text{PH}_3-\text{AsH}_3-(\text{NH}_3)-\text{H}_2$
 GaAlAs (用: AlGaAs)
 $\text{GaAlAs}-\text{GaAs}$ (用: $\text{GaAs}-\text{GaAlAs}$)
 $\text{GaAlAs}/\text{GaAs}/\text{GaAlAs}$
 GaAlAsSb (用: AlGaAsSb)
 GaAs
 a- GaAs
 半绝缘 GaAs
 多晶 GaAs
 $\text{GaAs}-\text{AlAs}$
 $\text{GaAs}-\text{AlGaAs}$ (用: $\text{GaAs}-\text{GaAlAs}$)
 $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$
 $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}/\text{M}$
 $\text{GaAs}/\text{GaAlAs}$
 $\text{GaAs}-\text{GaAlAsP}$

$\text{GaAs}/\text{GaAsP}/\text{GaAs}$
 $\text{GaAs}-\text{InGaAsP}$
 $\text{GaAs}-\text{GaInP}$
 $\text{GaAs}-\text{GaP}$
 GaAs/GaSb
 $\text{GaAs}-\text{Ga}_2\text{Se}_3$
 $\text{GaAs}-\text{Si}_3\text{N}_4$
 $\text{GaAs}-\text{ZnSe}$
 $\text{GaAs}-\text{阳极氧化物}$
 GaAsP
 $\text{GaAsP:N}/\text{GaP}$
 GaAsSb
 GaInAs (用: InGaAs)
 $\text{GaInAs}-\text{GaAs}$
 GaInAsP (用: InGaAsP)
 $\text{GaInAsP}-\text{InP}$ (用: $\text{InGaAsP}-\text{InP}$)
 GaInAsSb
 GaInP
 GaInP/InP
 GaInSb
 GaN
 GaP
 $\text{GaP}-\text{AlGaAs}-\text{M}$
 GaS
 GaSb
 a- GaSb
 $\text{GaSb}-\text{AlGaAsSb}$ (用: $\text{AlGaAsSb}-\text{GaSb}$)
 GaSbGe
 GaSe
 $\text{GaSe}-\text{Pb}$
 $\text{GaSe}-\text{PbSe}$
 GaSe_2
 Ga_2Se_3
 $\text{Ga}_2\text{Se}_3-\text{In}_2\text{Se}_3$
 GaSnSe
 Ga_2Te_3
 Gd
 $\text{Gd}-\text{Ge}-\text{Se}$
 $(\text{Gd}-\text{Pt})-\text{Si}$
 $(\text{Gd}-\text{V})-\text{Si}$
 Gd_3CrSe_6
 GdSe
 $\text{Gd}_2\text{Se}_3-\text{GeSe}_2$
 $\text{GdTe}-\text{GaTe}$

Ge
 a- Ge
 多晶 Ge
 $\text{Ge}-\text{Ag}$
 $\text{Ge}-\text{Au}$
 $\text{Ge}-\text{CsI}$
 $\text{Ge}-\text{GaAs}$
 $\text{Ge}-\text{In}-\text{Te}$
 $\text{Ge}-\text{碱金属}$
 $\text{Ge}-\text{Mn}-\text{Te}$
 $\text{Ge}-\text{S}$
 $\text{Ge}-\text{Se}$
 a- $\text{Ge}-\text{Se}-\text{Ga}$
 $\text{Ge}-\text{Si}$ (用: $\text{Si}-\text{Ge}$)
 GeBr_4
 GeCoTe
 GeCrTe
 GeFeTe
 Ge_3N_4
 GeNiTe
 GeO_2
 GeS
 GeS_2
 GeSe
 a- GeSe
 GeSe_2
 GeTe
 a- GeTe
 $\text{GeTe}-\text{AgBiTe}_2$
 $\text{GeTe}-\text{AgSbTe}_2$
 $\text{GeTe}-\text{FeGe}_2$
 $\text{GeTe}-\text{PbTe}$

H

H
 H_2-Ar
 H_2/O_2
 $\text{H}_2-\text{SiHCl}_3$
 HCl
 HF
 HNO_3
 H_2O_2
 H_2S
 He
 Hf

Hg	InP/InGaAs(用: InGaAs/InP)	LnF ₃
Hg-InP	InP/InGaAsP(用: InGaAsP/	M
HgCdCrSe	InP)	
HgCdTe	InP/InGaAsP/InP	M-CdS
HgCdTe-Al ₂ O ₃ -Pb	InP/ITO(铟锡氧化物)	M-CdSe
HgCdTe/CdTe	InP-M	M-InSb
Hg ₂ ClBr	InP-PCl ₃ -H ₂	M-Zn ₃ P ₂
HgCrS ₄	InP/V ²⁺ -V ³⁺	Mg
HgCr ₂ Se ₄	InP-氧化物	Mg-SiO ₂ -Si
HgGa ₂ S ₄	InPS ₄	Mg-Zn ₃ P ₂
HgI ₂	InS	MgF ₂
HgMnTe	In ₂ S ₃	MgO
HgSe	InSb	MgS
HgTe	多晶InSb	Mg ₇ (Se ₅ Te ₅),
HgTe-CdTe	InSb/Bi	Mn
I	InSb-CdTe	Mn ₂ O ₃
	InSb-InBi	MnTe-CdTe
I	InSb-In ₂ GeTe	Mo
In	InSb-NiSb	Mo/Si
In-Zn ₃ P ₂	InSb-TlSb	MoS ₂
In-无金属砷青	InSbI	MoSe ₂
InAs	InSe	MoSi ₂
InAs-CdTe	In ₂ Se ₂ /Si	MoS ₂ /I/I ₂ /C
InAs-GaSb	In ₂ Se ₃	N
InAsP	In ₄ Se ₃	
InAsSb	In ₂ Te ₃	N
InAsSbP	ITO	N ₂ +O ₂ 混合物
InBi-Bi	ITO/InP	NF ₃
InGaAlP	ITO-Si	NH ₃ (氨)
InGaAs	ITO-多晶硅	NO
InGaAs-GaSbAs	ITO-Si ₃ N ₄ -Si	NO ₂
InGaAs/InAlAs	ITO-SiO _x -Si	Na
InGaAs/InGaAsP	K	NaCl
InGaAs/InP		NaF/CaF ₂
InGeAsP	K	NaF·H ₂ SO ₄
InGaAsP-InP	K ₂ Cr ₂ O ₇ -H ₂ SO ₄ -HCl	Na ₂ S _x
InGaP	KOH	Nb
InN	Kr(氪)	Nb/Al
In ₂ O ₃	L	Nb-NbO _x -Pb
In ₂ O ₃ -Si		Nb-Te-Nb
InP	L ₃ In	Nb-氧化物-Pb
a-InP	Li	NbN-aSi-Nb
半绝缘InP	LiInS ₂	Nd
InP/CdS	LiNbO ₃	Ni
InP/GaAs	Ln	Ni-Cu

Ni/Ge
Ni-Si
Ni/焊料
NiFe
NiSi
NiSi-Si
NiSi₂
Ni₂Si
NiTiO₃

O

O

P

P
Pa(钷)
PCl₃
PH₃
P₃N₅
P₂O₅
Pb
Pb合金
Pb/PbSSe
Pb-Sn
Pb-Sn-Se
Pb-Sn-Te
PbCdTe
PbI₂
PbMnTe
PbO
PbS
PbSSe
PbSe
PbSe-SnSe
PbSeSnTe
PbSeTe
PbSnSc
PbSnTe
多晶PbSnTe
PbSnTe-Si
PbTe
PbTe-GaAs
PbTe-GeTe
PbTe-PbSnTe
PbTe-Si
PbTe-SnTe

PbTiO₃
(Pb, Ln)(Ti, Mn)O₃
Pb₂Ru₂O₆
Pd
Pd-Cr-Cu
Pd-Ni-Cu
Pd-Si
Pd-a-Si:H
PdAs₂
PdGa
PdO
a-Pd₈₀Si₂₀
a-PdSiCu
Pd₂Si
PrO_x-P₂O₅
Pt
Pt-Si
Pt-SiO_x
Pt-SiO₂-Si
PtSi
PtSi-Si
PtSi-Ti/W-Al
Pt₂Si

R

Ra(镭)
Ru(钌)
RuO₂
RuSi_{1.5}

S

S
SF₆
Sb
Sb-O-Te
Sb-Pt-Au
SbBiTeSe
SbF₅
SbSI
a-SbSe
Sb₂S₃/PbTe
Sb₂Te₃
Sc
Se
a-Se

a-Se-Al
a-Se-As-Te-Bi
a-Se-Bi
Se:As 合金
Se-As-Te
a-(Se-As-Te)
Se-CdO
Se-CdS
Se_{0.5}As_{0.5}
Se_{1-x}As_x-Se
Se_{0.43}Ge_{0.57}
SeGe
a-SeGe
SeGeTe
SeTe
Se_{1-x}Te_x
Si

a-Si
a-Si:(B,H)
a-Si:F
a-Si:H
a-Si:(H,Cl)
a-Si:H:F
a-Si:N
a-Si:O
硅带
硅片(见:一般主题索引)
硅膜
半晶硅
半绝缘多晶硅
多晶硅
多孔硅
微晶硅
冶金级硅
铸硅
a-Si-Pd
a-Si/氮化硅
a-Si/Si
a-Si-SiO₂
多晶硅/硅
多晶硅-SiO₂
多晶硅-SiO₂-多晶硅
Si-Ag
Si-Al
Si-As-Te

• 5 •

Si-Au
 Si-Au-Ag
 Si-Au-Al
 Si-CdS
 Si/CaF₂/Si
 Si/CoSi₂/Si
 Si-Cr
 Si-Ga
 Si-Ge
 Si-H
 Si:H
 Si/LiNbO₃
 Si-N
 Si-NiSi
 Si:P₂
 Si-Pd₂Si
 Si-PtSi
 Si-Si
 Si-SiGe 合金
 Si-SiO₂
 Si-SiO_x-Ag
 Si-SiO₂-Al
 Si-SiO₂-Al₂O₃
 Si-SiO₂-多晶硅
 Si/玻璃
 Si/硅化物
 Si/含水电解质
 Si-金属
 Si-钇硅化物
 SiBeON
 SiC
 a-SiC
 a-SiC:H
 a-SiC:H/a-Si:H
 SiCl₄
 SiCl₄-AsCl₃
 SiF₂
 a-SiGe
 a-SiGe:H
 SiH
 SiH₄(硅烷)
 a-SiH_x
 SiH₄-Ar
 SiH₄-N₂
 SiHCl₃

SiH₂Cl₂
 SiH₂Cl₂-H₂-N₂
 SiH₃Cl
 Si₃N₄
 a-Si₃N₄
 Si₃N₄/SiO₂/Si
 SiO_x
 a-SiO_x
 SiO₂
 a-SiO₂
 SiO₂/GaAs
 SiO₂/InGaAsP
 SiO₂/InSb
 SiO₂-Si₃N₄
 SiO₂-Ta₂O₅
 SiP
 Si₁₈Te₄₅As₂₈Ge
 SmS
 SmSe
 Sm₃Sb₄S₉
 Sm₃Sb₄Se₉
 Sn
 Sn/Ag/Ni
 Sn-GaAs
 SnO
 SnO₂
 a-SnO₂
 SnO₂/CdTe
 SnO₂/In₂O₃-SiO_x-Si
 SnO₂/Si
 SnO₂/SiO₂/Si
 Sn₂P₂S₆
 Sn₂P₂(Se_xS_{1-x})₆
 SnS
 SnS₂
 SnSe₂
 SnTe
 SnTe-GaAs
 SOC (陶瓷上的硅)
 SOS (蓝宝石上的硅)
 SrTiO₃

T

Ta
 Ta/Ge

α-Ta₂O₃
 Ta₂N
 TaSi₂
 TaSi₂/多晶硅
 Tb₂Se₃-GeSe₂
 Te
 多晶Te
 Te-Tl
 TeGe
 TeGeSb
 α-TeO₂
 Th(钍)
 Ti
 Ti-Pd-Ag
 Ti-Pd-Au
 Ti-Pt-Au
 Ti-TiN
 Ti/W/Au
 TiB₂
 TiN
 TiO₂
 TiO₂-SnO₂
 TiSi₂
 TiSi₂/多晶硅
 TiW/Au
 Tl
 Tl-As-Te
 Tl-Si-Te
Tl₃AsS₄
 Tl₃AsSe₂
 Tl₅As₂Te₃-Te
 TlBX₂
 TlBiTe₂
 TlGaSSe
 TlInSe₂-TlNdSe₂
 TlInTe₂-TlNdTe₂
 Tl₃PSe₄
 Tl₃PbBr
 TlPbI₃
 Tl₃PbI₅
 TlSbSe₂-PbSe
 TlSe-DySe
 Tl₂Se₃
 TlSnI₃
 TlSn₂I₅

V

VO₂
V₂O₃
V₂O₃-Si
V₂O₅
V₃Si

W

W
W-Ni
WSe₂
WSe₂/I⁻
WSi₂
W_xSi_{1-x}
WO₃
XeCl

Y

Y
Y-Si
Y₃Al₅O₁₂
Yb
Yb-Sb-Te
YbGeSe₃
Yb₂GeSe₄
YbS
YbSe
YbTe-Sb₂Te₃

Z

Zn
Zn-O
Zn-S-H₂
Zn-Se
ZnAl₂S₄
ZnAs₂
Zn₃As₂
ZnCdS
ZnCdS/CdTe
ZnCdS/Cu₂S
ZnCr₂S₄
ZnIn₂S₄
ZnMgS

ZnO
ZnO-Ag
ZnO-InP
ZnO-Si
ZnO-Sb₂O₃
ZnO/SiO₂
ZnO-SiO₂-Si
ZnP₂
Zn₃P₂

多晶Zn₃P₂

Zn₃P₂/ZnO
ZnS
ZnSSe
ZnSe

a-ZnSe

ZnSe/GaAs
ZnSe-ZnCdTe
ZnSeAs₂

ZnSiAs₂

Zn₂SiO₄

ZnSiP₂

ZnSnAs₂

ZnSnP₂

ZnTe

a-ZnTe

ZnTe-CdSe

ZnTeO

ZrO₂

Ⅲ族元素

Ⅲ族砷化物

V族元素

A^ⅠB^{ⅤⅠ}化合物

A^Ⅰ-B^Ⅰ-C^Ⅴ-D^{ⅤⅠ}系

A^ⅠB^ⅤC₂V系

A^ⅠB^Ⅴ化合物

A^ⅠC₂V化合物

A^ⅠB^{ⅤⅠ}化合物

A^ⅠB^Ⅴ化合物

半绝缘Ⅲ-V族材料

A^ⅠB^Ⅴ化合物/介质

B^ⅠC^Ⅴ-A^ⅠB₂^ⅠD₄^{ⅤⅠ}系

Ⅲ-V族四元系

A^ⅠV^{ⅤⅠ}化合物

A^ⅠV^{ⅤⅠ}-A^ⅠV^{ⅤⅠ}系

A^ⅠV^{ⅤⅠ}-NiSb(CoGe)系

A^ⅠV^{ⅤⅠ}C^{ⅤⅠ}化合物

螯合物

半磁性半导体

半导体

半导体-半导体

半导体-电介质

半导体-金属

半导性热聚物

半导性釉

半金属

苯胺黑

本征半导体

吡咯-氧

玻璃

玻璃态碳-a-InTe-玻璃态碳

玻璃状半导体

补偿半导体

超纯水

超导体-半导体-超导体

磁性半导体

氙

导电玻璃

导电性粘结剂

氮化钛

电解质

固态电解质

电解质-硅

电解质-氧化物-半导体

电解质-SiO₂-Si

电介质

电介质-半导体

电子材料

叠氮化物-酚醛树脂

丁烯-1砜(PBS)

多晶半导体

蒽衍生物

9、10-二氯蒽

9、10-二溴蒽

二甲基锌

二元化合物

发光体

钒酸盐

非均匀半导体

酚

酚醛树脂

钢	聚氨酯	难熔半导体
各向同性半导体	聚苯乙烯	难熔氧化物
共轭聚合物	聚苯酸	尼龙塑粉
固体	聚丙烯	凝胶
冠醚	聚丙烯腈(PAN)	PLT
光电子材料	聚砒	硼硅玻璃
光导体	聚合物	气体
光敏材料	聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)	纤锌矿
硅化铍	聚偏氟乙烯(PVDF)	铅盐
硅化物	聚三苯基	染料
硅化物-硅	聚四氟乙烯	荧光染料
硅树脂	聚碳酸酯	有机染料
硅树脂松香脂	聚酰亚胺	热载流子半导体
硅酸铋	聚氧化乙烯	三乙基铟
硅酸锑	聚酯	三乙基镓
硅橡胶	绝缘体	三元化合物
过渡金属	a-绝缘体	石墨
合金	绝缘体-金属	树脂
红宝石	科达747(K747)	水
红外材料	空气	水晶紫
化合物半导体	蓝宝石	水汽
环氧树脂	量子电子材料	闪锌矿半导体
环脂环氧树脂	磷硅玻璃	四甲基锡
混晶	磷光体	TTF-TCNQ
极性半导体	磷酸二氢铵(ADP)	陶瓷
甲基丙腈	磷酸镉锌	铁磁半导体
甲基 α -三氟异丁烯酸盐	磷钼氧化物	铁磁性膏
甲酸	硫代桔酸镉	铁电半导体
尖晶石	硫砷银矿	铁电体
简并半导体	硫属化合物	铁氧体
碱金属	ⅢB族元素单硫属化合物	铁氧体-半导体
介质	汞硫属化合物	铜膏
介质-SiO ₂ -Si	金属硫属化合物	β -铜酞花青
金刚石	铝硫属化合物	无定形半导体(含: 非晶半导体)
金刚石半导体	铅硫属化合物	无定形钒氧化物
金属	氢化硫属化合物	无序半导体
金属-半导体	锌硫属化合物	稀土金属
金属-绝缘体	铜硫属化合物	稀土金属-Si
金属-铜酞花青	镉硫属化合物/多硫化合物	锡酸镉
金属硅化物	卤素	O-硝基苄酯
难熔金属硅化物	铝膏	硝基芳香族半导体
金属硅化物/多晶硅(polycide)	氯化物	硝酸
金属酞花青(MPc)	络合物	压电半导体
金属氧化物	MEM(TCNQ) ₂	亚碲酸钒
晶体-液体	MRS	氧化剂

氧化物
热氧化物
天然氧化物
阳极氧化物
氧化物/Ⅲ-V族化合物
氧化物/GaAs
氧化铁
多晶氧化铁

液晶
乙醚甘油脂
乙腈
乙烯
异酞酸己二烯
银环氧焊剂
荧光体
有机半导体

有机光导体
元素半导体
窄隙半导体
粘结剂
锗烷
直接能隙半导体
重掺杂半导体
重氮基苯醌

主题词一览表

A

ABLE
AMD公司
AMI公司
AMS微机模块系统
ASAP
 α 粒子
阿拉伯国家
爱因斯坦关系
暗斑
暗电导
暗电动势
暗电流
凹槽氧化物绝缘结构(ROI)
凹陷

B

BASIC程序
BIGFET阵列
靶
斑点
斑点交迭技术
半导电性
半导体电子学
半导体工厂
半导体工业
半导体激光器(含:激光二极管)
CW激光器
V槽激光器
超晶格激光器
单模激光器

电荷转移激光器
电子束泵激光器
短腔激光器
多层结构激光器
非均匀半导体激光器
分布反馈(DBF)激光器
干涉激光器
沟道激光器
沟道-衬底-平面(CSP)激光器
横向结条形(TJS)激光器
红外激光器
集成激光器
脊形波导激光器
激元激光器
阶梯衬底激光器
可见光激光器
量子阱异质结(QWH)激光器
平凸波导(PCW)激光器
片状激光器
双波长激光器
双波导激光器
双异质结(DH)激光器
锁模激光器
台面衬底隐埋(MSB)异质结激光器
条形激光器(含:窄条激光器)
条形双异质结激光器
同质结激光器
相控阵激光器
隐埋光学波导激光器
隐埋新月形激光器
隐埋异质结(BH)激光器

异质结激光器
增益导引激光器
窄条浅质子注入激光器
注入激光器
自耦激光器
半导体激光器组件
半导体器件
超高速器件
非晶半导体器件
分立半导体器件
高温器件
光电器件(另立主题)
功率器件
毫米波器件
微波器件
亚微米器件
半导体物理学
半导体阳极
半定制集成电路
版图
版图设计
曝光(参:光刻,复印)
X射线曝光
电子束曝光
接触曝光
离子束曝光
投影曝光
曝光剂量
曝光系统
电子束曝光系统
分步重复曝光机
投影曝光装置

阵列光学曝光系统
 饱和浓度
 饱和速度
 饱和特性
 饱和压降
 保护
 保持特性
 贝耳实验室
 倍频效应
 倍频器
 倍增因子
 闭管法
 比较-相等检验法
 比较器
 比例缩小
 比热
 变分法
 变换器(含: 转换器)
 波长变换器
 光电转换器
 模/数(A/D)变换器
 热光生伏特(TPV)转换器
 数/模(D/A)变换器
 太阳能转换器
 变阻器
 变频
 变频器
 编程
 激光编程
 编程器
 编码-译码器(CODEC)
 编址
 边界
 边界态
 边界条件
 边缘清晰度
 边缘效应
 边缘限定技术
 标准单元法
 表面
 表面波
 表面重构
 表面处理
 表面浮雕
 表面光伏法

表面光伏效应
 表面化学处理
 表面漏泄
 表面结构
 表面能
 表面声波(用: 声表面波)
 表面势
 表面势垒结构
 表面态
 表面弹性波元件
 表面效应
 表面性质
 表面沾污
 表面组分
 表面阻抗
 标记
 标准单元
 标准化
 背表面场(BSF)
 背面打毛
 背栅
 波长
 波长调制
 波导
 波兰
 波谱学
 波束宽度
 波形
 剥层法
 剥离
 热膨胀剥离
 等离子体剥离
 玻璃化
 薄膜
 介电薄膜
 薄膜衬底
 薄膜导体
 薄膜电路
 薄膜电容器
 薄膜电阻
 薄膜功能器件
 薄膜工艺
 薄膜监测器
 补偿
 自补偿

补偿电路
 不辐射区
 不均匀性
 不可逆效应
 不稳定性
 布局(参: 布线, 设计, CAD)
 布里渊区
 布拉格反射波导
 布尔代数
 布尔运算
 布尔微分算子
 布线(含: 走线; 参: 布局)
 多层布线
 自动走线
 布线器

C

C-V法
 C-V特性
 CASMOS
 CDP1805
 CELTIC
 CLEFT(横向外延模解理转移)
 CODASYL
 材料参数
 彩色电视机
 采样保持电路
 参数失配
 参考电压发生器
 操作码
 槽口
 测定
 测量
 磁光测量
 光学测量
 电学测量
 非破坏性测量
 霍耳测量
 激光延迟测量
 测量误差
 测试
 加速测试
 生产测试
 在线测试
 自测试

测试板
测试电路
测试结构
测试设备
测试图形
测位技术
测温法
层错
 氧化感生堆垛层错(OSF)
层状结构
擦除
产生-复合中心
掺杂
 光掺杂
 光电掺杂
 激光掺杂
 离子束掺杂
 汽相掺杂
 调制掺杂
 选择掺杂
 中子嬗变掺杂
 自掺杂
掺杂剂
掺杂分布
掺杂浓度
掺杂速率
掺杂效应
场论
场效应
场致发射
超导环路
超导性
超晶格
超结构
超精细结构
超声波
超声吸收
车间
衬底
 台式衬底
 多层衬底
 陶瓷衬底
 陶瓷敷钢衬底
 外延衬底
衬底偏压

衬底掺杂
衬底夹具
衬底加热
衬底温度
沉淀
乘法器
成本
成本有效性
成份
成核
成键
成品率
成像特性
程序
尺寸
尺寸量子化
尺寸效应
弛豫
 电压弛豫
 自旋弛豫
 自旋晶格弛豫
弛豫时间
弛豫振荡
冲电气公司
冲击波
重构
重排
抽取
畴
 声畴
出错
处理效应
除法器
触发器
传播
传播损耗
传播常数
传感器
 LC振荡传感器
磁传感器
电流传感器
光传感器
化学传感器
霍尔传感器(参: 霍尔器件)
激光传感器

结露传感器
离子传感器
流体方向传感器
浓度传感器
气体传感器
色传感器
矢量传感器
湿度传感器
速度传感器
陶瓷传感器
微波功率传感器
温度传感器
物理传感器
压力传感器
传感能力
传输
传输特性
传输线模型
传输延迟时间
传真
传真设备
穿通
穿通几率
串联电阻效应
串扰
串音
窗口材料
纯度
磁表面波
磁场
 量子化磁场
磁场电效应
磁场电效应器件
磁带录相机
磁导率
磁光性质
磁化率
磁敏二极管效应
磁敏效应
磁凝结
磁-热电效应
磁矢量
磁声子振荡
磁双折射
磁通量计

磁消偏振效应
 磁性扫描
 磁性有序化
 磁学性质
 磁振子
 磁阻
 负磁阻
 横向磁阻
 磁阻系数
 粗糙度
 簇集
 催化
 脆性
 淬火
 淬火效应
 萃取
 存取电路
 存储逻辑阵列(SLA)
 存储器
 EAROM(电可改写 只读存储器)
 EEPROM(电可抹可编程只读存储器)
 EPROM(可抹可编程 只读存储器)
 PROM(可编程只读存储器)
 磁泡存储器
 动态随机存取存储器(DRAM)
 多值只读存储器
 非易失存储器
 光学存储器
 静态随机存取存储器(SRAM)
 控制存储器
 容错动态随机存取存储器
 声电存储器
 双极存储器
 随机存取存储器(RAM)
 相联存储器
 虚拟存储器
 只读存储器(ROM)
 准静态随机存取存储器
 存储器/逻辑阵列(SLA)
 存储单元
 高容量存储单元(Hi-C)

三管单元
 存储开关
 存储库
 存储时间
 存储相关器
 存储效应
 非易失性存储效应
 存储性能
 存储阵列
 错误
 错误模拟器

D

DELILA
 DIGISM系统
 DOE计划
 大信号模型
 带到带工艺(RTR)
 带间效应
 带宽
 单板计算机
 单晶炉
 单块集成
 单块结型器件
 单模控制
 单色仪
 单器件井(SWD)
 单向器件
 单元设计系统(CDS)
 单元汇编语言(CAL)
 丹倍效应
 氮化
 弹道传输
 导电机理
 导纳
 交流导纳
 输出导纳
 导热夹
 导体带
 导通
 导线
 倒相器
 倒装片
 德拜模型
 德克萨斯公司

等离子体
 表面等离子体
 磁等离子体
 多极等离子体
 热等离子体
 θ 收缩等离子体
 等离子体特性
 等离子体反应器
 等离子体化学
 等能面
 等温电容瞬态谱法
 等效电路
 低频响应
 低频强度起伏
 底板
 地址
 电-光特性
 电参数
 电场
 高频电场
 横向电场
 阈值电场
 结电场
 电场强度
 电触发
 电磁波
 电磁场
 电磁干扰
 电磁脉冲
 电磁扫描系统
 电磁效应
 电磁性质
 电磁振荡
 电导
 磁致电导
 场效应电导
 非欧姆电导
 交流电导
 热激电导
 剩余电导
 隧道电导
 跳跃电导
 亚阈值电导
 阈值电导

杂质电导	电离	电平检测
直流电导	碰撞电离	电平敏感扫描设计(LSSD)
电导率	光致电离	电气设备
表面电导率	隧道电离	电迁移
微波电导率	电离导体	电热学模型
电导模式	电离率	电容
电镀	电离损耗谱	磁致电容
电镀层	电离速率比	寄生电容
电反射率	电离系数	结电容
电-光特性	电力管理	空间电荷电容
电感	电流	瞬时电容
电感矩阵	表面复合电流	微分电容
电荷	电子电流	电容法
点电荷	电子束感生电流	电容器
感应电荷	短路电流	MIS电容器
体电荷	反向电流	MNOS电容器
正电荷	负瞬时电流	MOS电容器
电荷泵	横向电流	PDP(多晶硅-介质-多晶硅)
电荷产生特性	寄生电流	电容器
电荷反转	空间电荷限制电流(SCL)	陶瓷电容器
电荷分布	扩散电流	电容谱
电荷积累	离子束感生电流	电视屏
电荷密度	漏电流	电视调谐
电荷密度波	漏泄电流	电瞬态方法
电荷容量	欧姆电流	电声互作用
电荷注入	热激电流	电声特性
电荷注入器	少子电流	电声效应
电荷转移	隧穿电流	电位
电荷转移器件(CTD)	阈值电流	电位分布
表面CCD(SCCD)	噪声电流	电物理性质
电荷耦合器件(CCD)	电流倍增	电效应
电荷注入器件(CID)	电流叠加原理	电学计算
斗链器件(BBD)	电流分布	电学极限
结型CCD(JCCD)	电流开关	电学特性
埋沟CCD	电流脉冲	电学性质
双沟道CCD	电流漂移特性	电压
体CCD	电流收集效率	电源电压
电极	电流调制	补偿电压
半导体电极	电流振荡	穿通电压
光电极	电流注入	反向电压
基区电极	电路参数	工作电压
透明电极	电路分析	基极电压
酵素电极	电路技术	击穿电压
电极化率	电路连接	开关电压
电解	电路应用	开路电压